

双通道带立体声耳机模式AB类音频放大器

概要

CS4863是一款双桥音频功率放大器芯片，采用5.0V电源供电；在THD+N小于1.0%情况下，能为一个4Ω的负载提供2.2W的连续功率或者3Ω的负载提供2.5W的连续功率。此外，当接立体耳机时，芯片可以单端工作模式驱动立体耳机。

CS4863双通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的，它采用表面贴装技术，只需少量的外围器件，便使系统具备高质量的音频输出功率。CS4863采用双通道设计使芯片具有了桥式联接扬声器放大和单终端立体耳机放大两种工作模式，简化了音频系统的外围电路设计。

CS4863内置了低功耗待机电路和过热保护电路，同时内置了杂音消除电路，可以消除芯片启动和关断过程中的咔嗒声或噼噓声。

CS4863提供了SOP16L, TSSOP16L-PP和DIP16L三种封装形式，额定的工作温度范围为-40°C至85°C。

封装

- SOP16L/TSSOP16L-PP/DIP16L
- 其他客户要求的封装类型

描述

- 每通道输出功率
 PO at 1% THD+N, V_{DD} = 5V
 R_L = 8 Ω 1.33W(典型值)
 R_L = 4 Ω 2.20W(典型值)
 PO at 1% THD+N, V_{DD} = 3.6V
 R_L = 8 Ω 0.75W(典型值)
 R_L = 4 Ω 1.10W(典型值)
- 工作电压范围：2.5V到5.5V
- “咔嗒声和噼噓声”抑制电路
- SE模式, R_L = 32Ω, 输出平均功率75mW, THD_(max) < 0.1%
- 低关断电流 (< 0.1μA)
- 过流保护，短路保护和热保护
- 符合RoHS的无铅封装

应用:

- 移动电话
- 便携式DVD播放机
- 笔记本电脑
- 数码相框
- USB接口的扬声器

典型应用线图 1

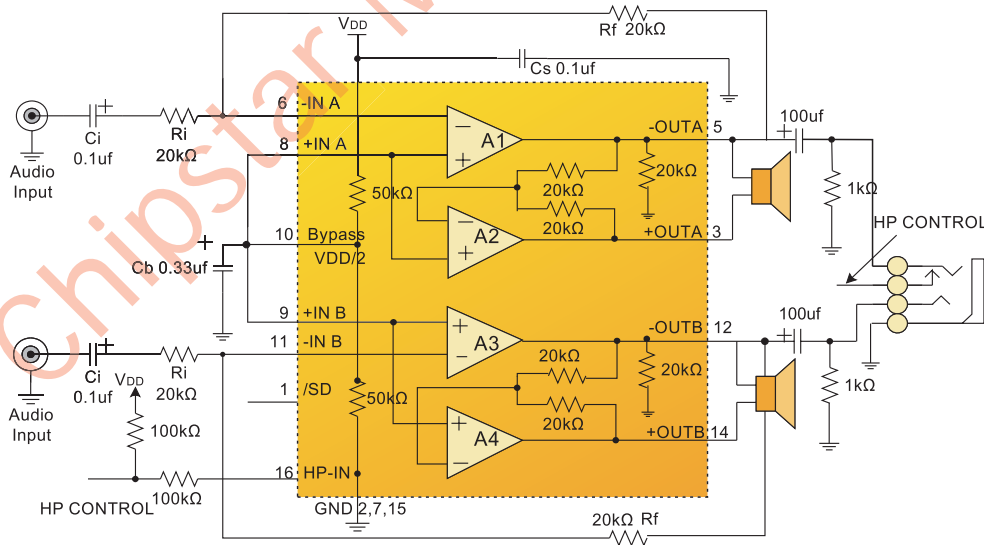
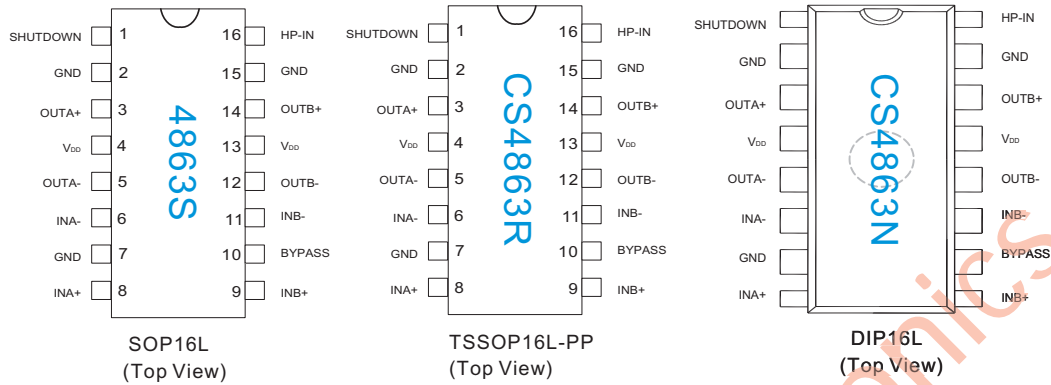


图 1 CS4863 应用线路图

管脚排列以及描述(图2)



管脚说明

CS4863N/R/S管脚	说明	输入/输出	功能
1	SHUTDOWN	输入	关断端口,高电平关断
2,7,15	GND	地	接地端
3	OUTA+	输出	正向输出端A
4,13	V _{DD}	电源	电源端
5	OUTA-	输出	反向输出端A
6	INA-/INA	输入	反向输入端A
8	INA+	输入	正向输入端A
9	INB+	输入	正向输入端B
10	BYPASS	输入	电压基准端
11	INB-/INB	输入	反向输入端B
12	OUTB-	输出	反向输出端B
14	OUTB+	输出	正向输出端B
16	HP-IN	输入	耳机/立体模式选择

极限参数表¹

参数	描述	数值	单位
V _{DD}	无信号输入时供电电源	6	V
V _I	输入电压	-0.3 to V _{DD} +0.3	V
T _J	结工作温度范围	-40 to 150	°C
T _{SDR}	引脚温度 (焊接15秒)	220	°C
T _{STG}	存储温度范围	-65 to 150	°C

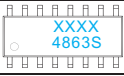


推荐工作环境

参数	描述	数值	单位
V _{DD}	电源电压	2.5~5.5	V
T _A	环境温度范围	-40~85	°C
T _J	结温范围	-40~150	°C

热效应信息

参数	描述	数值	单位
$\theta_{JA}(SOP)$	封装热阻---芯片到环境热阻	20	°C/W
$\theta_{JC}(SOP)$	封装热阻---芯片到封装表面热阻	80	°C/W
$\theta_{JA}(TSSOP)$	封装热阻---芯片到环境热阻	2	°C/W
$\theta_{JC}(TSSOP)$	封装热阻---芯片到封装表面热阻	58	°C/W
$\theta_{JA}(DIP)$	封装热阻---芯片到环境热阻	20	°C/W
$\theta_{JC}(DIP)$	封装热阻---芯片到封装表面热阻	63	°C/W

订购信息

产品型号	封装形式	器件标识	包装尺寸	卷带宽度	数量
CS4863S	SOP16L			管装	
CS4863R	TSSOP16L-PP			管装	
CS4863N	DIP16L			管装	

ESD 范围

ESD 范围HBM(人体静电模式) ----- ±4kV
ESD 范围MM(机器静电模式) ----- ±400V

1. 上述参数仅仅是器件工作的极限值，不建议器件的工作条件超过此极限值，否则会对器件的可靠性及寿命产生影响，甚至造成永久性损坏。
2. 当使用CS4863R时,PCB板放置的地方,需要有散热设计.使得CS4863底部的散热片和PCB板的散热区域相连，并通过过孔和地相连。

电气参数 ($V_{DD}=5V, T_A=25^{\circ}C$, 除非特殊说明)

参数	描述	测试条件	CS4863系列			单位
			最小值	典型值	最大值	
V_{DD}	供电电源		2.5			V
					5.5	V
I_{DD}	静态电流	$V_{IN}=0V, I_O=0A, HP-IN=0V$		10	20	mA
		$V_{IN}=0V, I_O=0A, HP-IN=4V$		7		
I_{SD}	关断电流	Shutdown管脚接地		0.04	1	μA
V_{IH}	SD,HP管脚输入高电平				4.0	V
V_{IL}	SD,HP管脚输入低电平		0.9			V

桥接模式电气特性 ($V_{DD}=5V, T_A=25^{\circ}C$, 除非特殊说明)

参数	描述	测试条件	CS4863系列		单位	
			典型值	极限值		
V_{OS}	输出失调电压	$V_{IN} = 0V$	5	50	mV(max)	
P_O	输出功率	THD= 1%, f = 1 kHz CS4863R, $R_L=3\Omega$	2.50		W	
		CS4863R, $R_L=4\Omega$	2.20		W	
		CS4863系列, $R_L=8\Omega$	1.33		W	
		THD+N = 10%, f = 1 kHz CS4863R, $R_L=3\Omega$	3.20		W	
		CS4863R, $R_L=4\Omega$	2.70		W	
THD+N	总谐波失真	20 Hz \leq f \leq 20 kHz, $A_{VD} = 2$ CS4863R, $R_L=4\Omega, P_O=2W$ CS4863系列, $R_L=8\Omega, P_O=1W$			%	
			CS4863系列, $R_L=8\Omega$	0.02		
			THD+N=1%, f=1kHz, $R_L=32\Omega$	0.37		W
PSRR	电源抑制比	$V_{DD} = 5V, V_{RIPPLE} = 200mV_{RMS}, R_L = 8\Omega$ $C_B = 1.0\mu F$	67		dB	
X_{TALK}	通道隔离度	f = 1 kHz, $C_B = 1.0 \mu F$	90		dB	
SNR	信噪比	$V_{DD} = 5V, P_O = 1.1W, R_L = 8\Omega$	98		dB	

单端模式电气特性 ($V_{DD}=5V, T_A=25^{\circ}C$, 除非特殊说明)

参数	描述	测试条件	CS4863系列		单位
			典型值	极限值	
V_{OS}	输出失调电压	$V_{IN} = 0V$	5	50	mV(max)
P_O	输出功率	THD+N=0.5%, f=1kHz, $R_L=32\Omega$	85	75	mW(min)
		THD+N=1%, f=1kHz, $R_L=8\Omega$	340		mW
		THD+N=10%, f=1kHz, $R_L=8\Omega$	440		mW
THD+N	总谐波失真	20 Hz \leq f \leq 20 kHz, $A_{VD} = -1, P_O=75mW, R_L=32\Omega$	0.2		%
PSRR	电源抑制比	$V_{RIPPLE} = 200mV_{RMS}, R_L = 8\Omega, C_B = 1.0\mu F$	52		dB
X_{TALK}	通道隔离度	f = 1 kHz, $C_B = 1.0 \mu F$	60		dB
SNR	信噪比	$V_{DD} = 5V, P_O = 340mW, R_L = 8\Omega$	95		dB

典型特征曲线

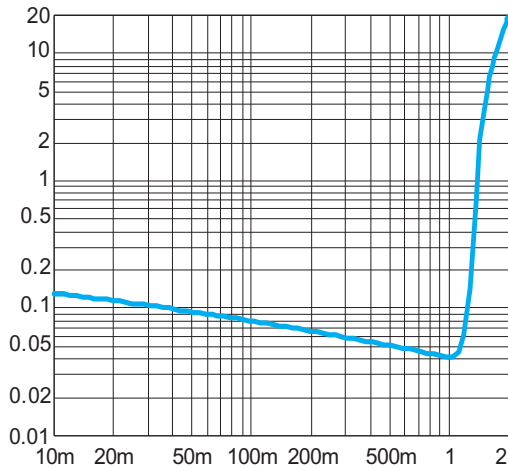


Figure 3. THD+N vs. Output Power
5V, 80hm, BTL at f=1 kHz

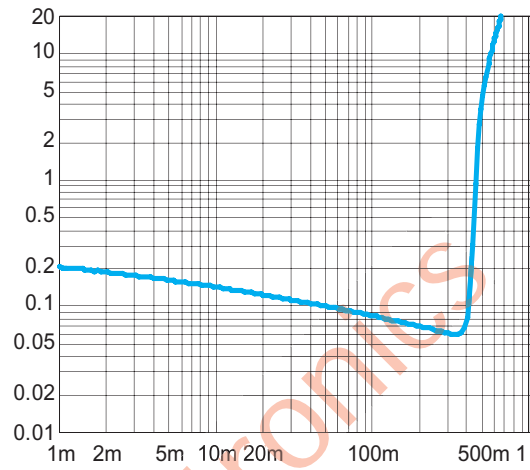


Figure 4. THD+N vs. Output Power
3V, 80hm, BTL at f=1 kHz

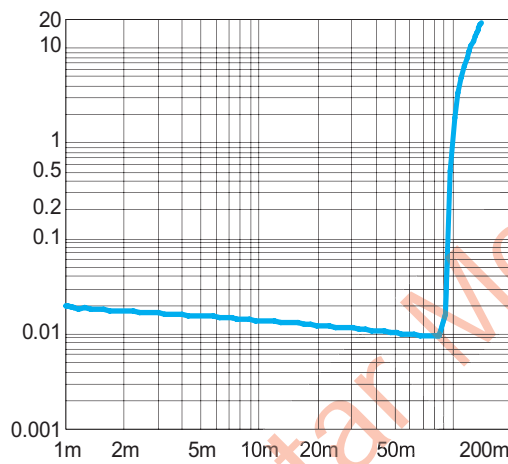


Figure 5. THD+N vs. Output Power
SE mode, 5V, 320hm, f=1 kHz

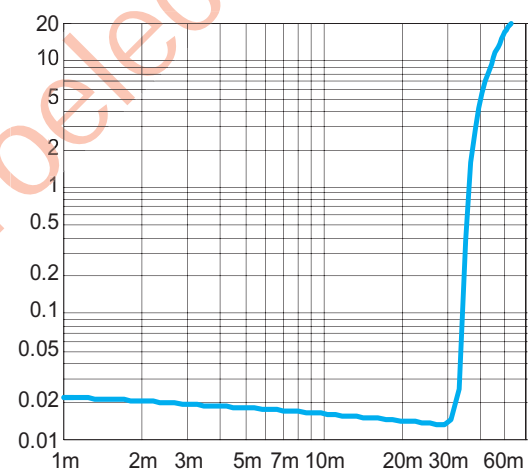


Figure 6. THD+N vs. Output Power
SE mode, 3V, 320hm, f=1 kHz

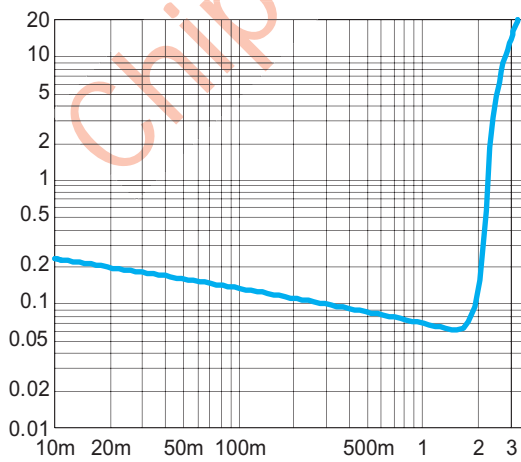


Figure 7. THD+N vs. Output Power
BTL mode, 5V, 40hm, f=1 kHz

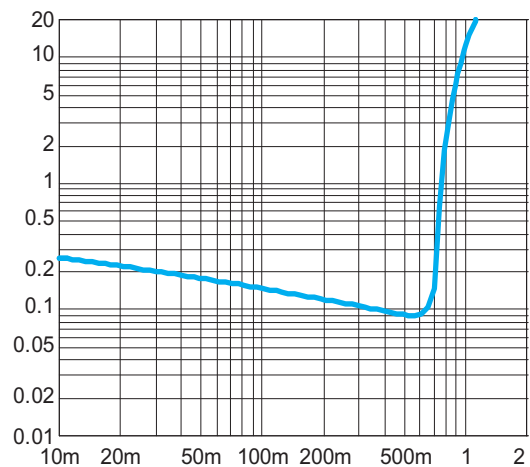


Figure 8. THD+N vs. Output Power
BTL mode, 3V, 40hm, f=1 kHz

典型特征曲线

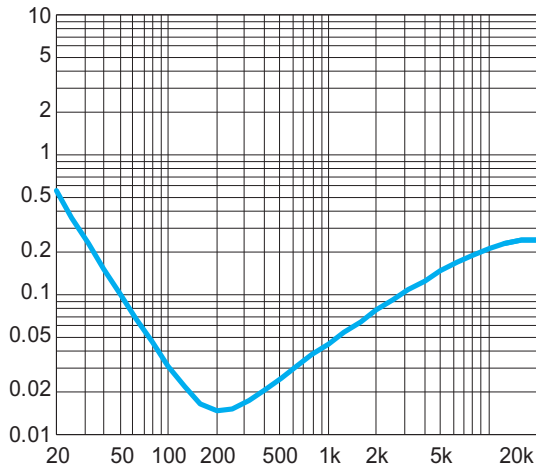


Figure 9. THD+N vs. Frequency
BTL mode, 5V, 8Ohm, Po=800mW

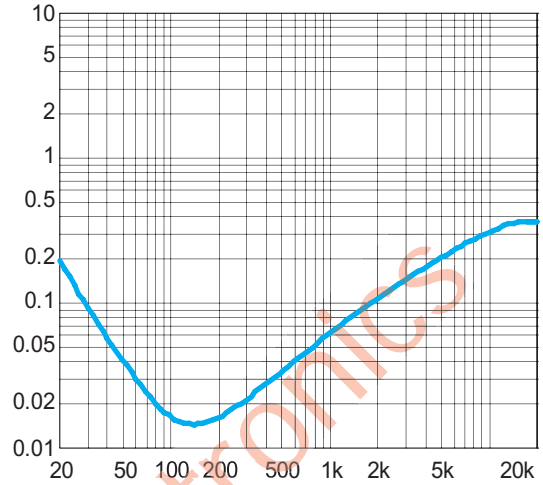


Figure 10. THD+N vs. Frequency
BTL mode, 3V, 8Ohm, Po=300mW

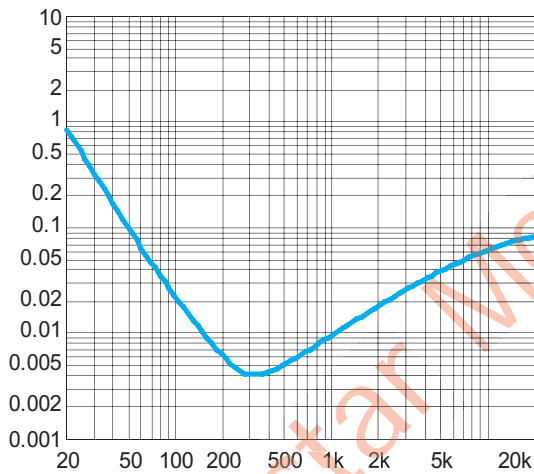


Figure 11. THD+N vs. Frequency
SE mode, 5V, 32Ohm, Po=70mW

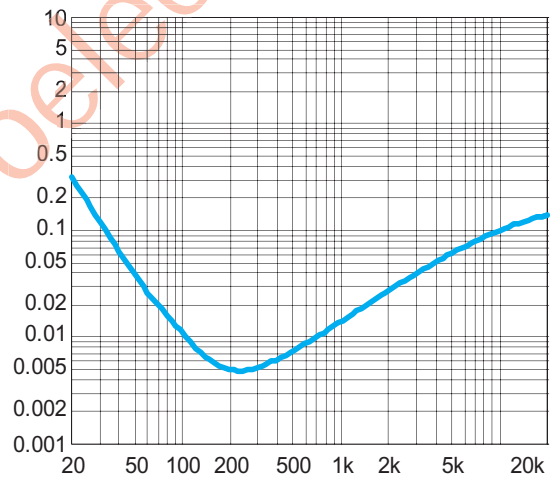


Figure 12. THD+N vs. Frequency
SE mode, 3V, 32Ohm, Po=20mW

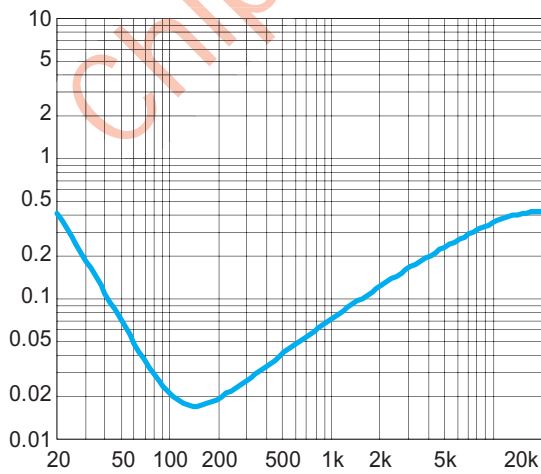


Figure 13. THD+N vs. Frequency
BTL mode, 5V, 4Ohm, Po=1W

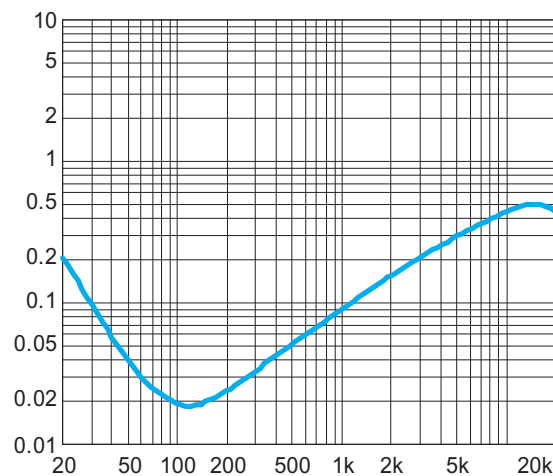


Figure 14. THD+N vs. Frequency
BTL mode, 3V, 4Ohm, Po=500mW

典型特征曲线

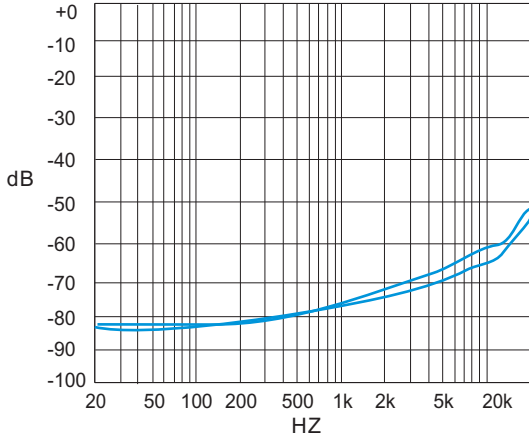


Figure 15. PSRR vs. Freq
BTL mode, 5V, 80ohm, 200mVpp
Input terminated

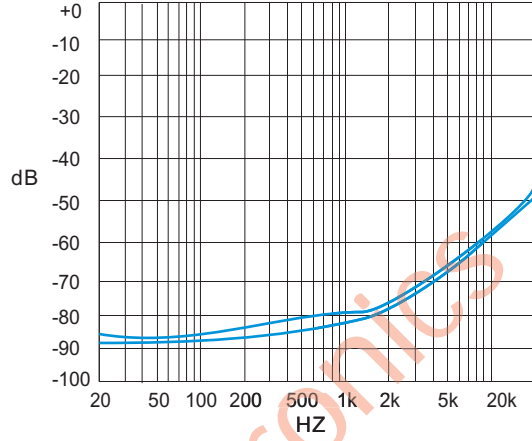


Figure 16. PSRR vs. Freq
BTL mode, 3V, 80ohm, 200mVpp
Input terminated

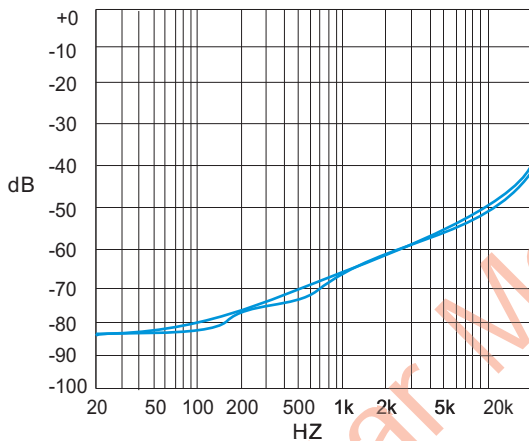


Figure 17. PSRR vs. Freq
BTL mode, 5V, 80ohm, 200mVpp
Input unterminated

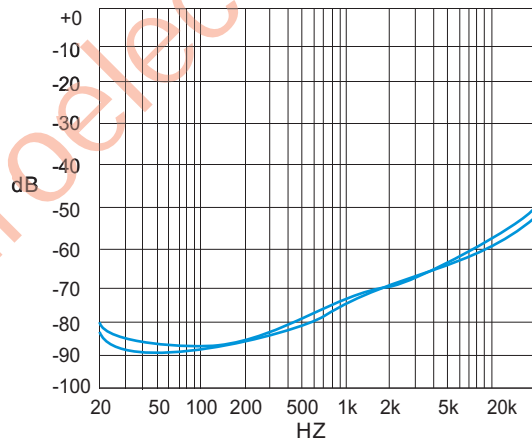


Figure 18. PSRR vs. Freq
BTL mode, 3V, 80ohm, 200mVpp
Input unterminated

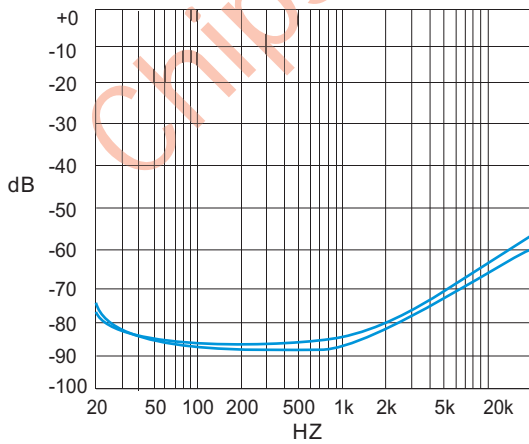


Figure 19. PSRR vs. Freq
SE mode, 5V, 320ohm, 200mVpp
Input terminated

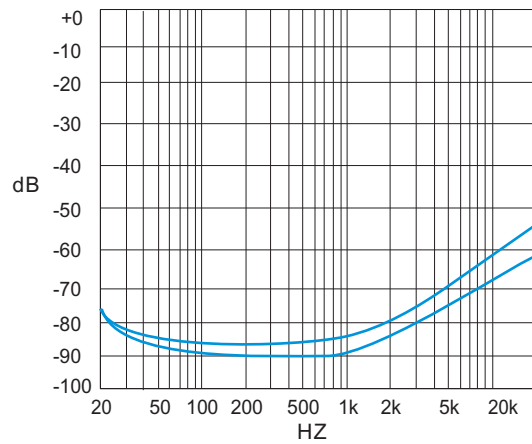


Figure 20. PSRR vs. Freq
SE mode, 3V, 320ohm, 200mVpp
Input terminated

典型特征曲线

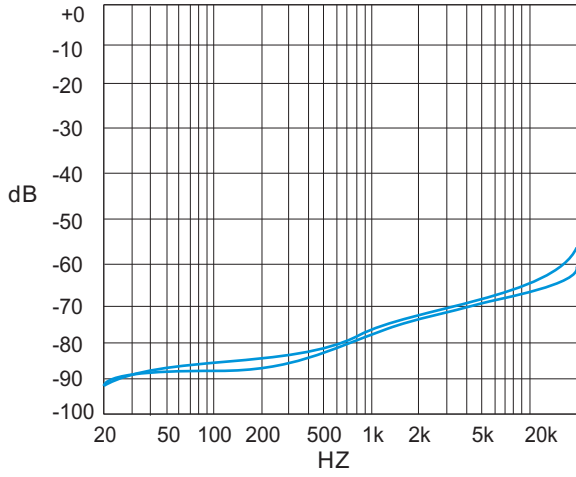


Figure 21. PSRR vs. Freq
SE mode, 5V, 320hm, 200mVpp
Input unterminated

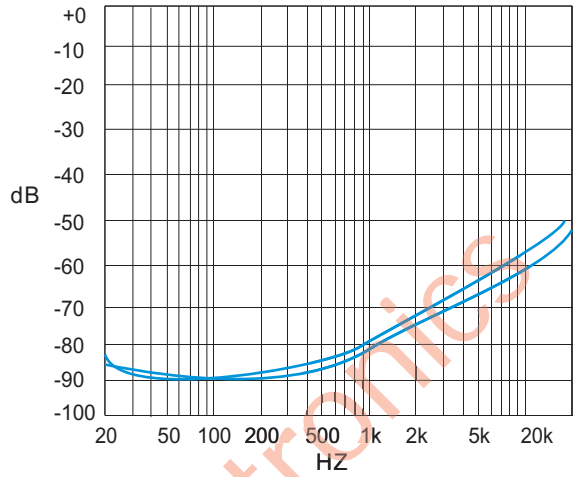


Figure 22. PSRR vs. Freq
SE mode, 3V, 320hm, 200mVpp
Input unterminated

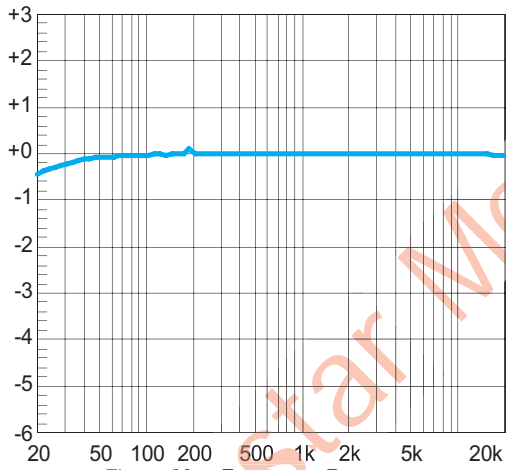


Figure 23. Frequency Response
BTL mode, 5V, 80hm

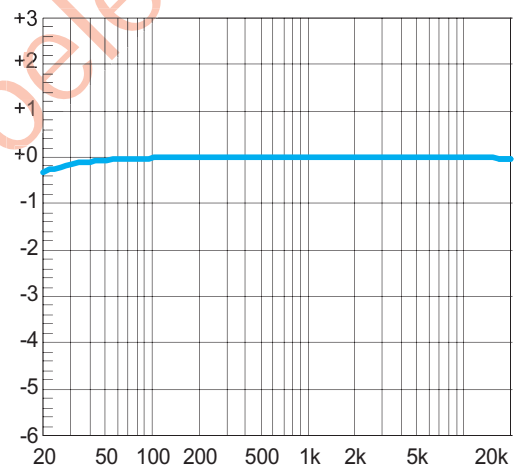


Figure 24. Frequency Response
BTL mode, 3V, 80hm

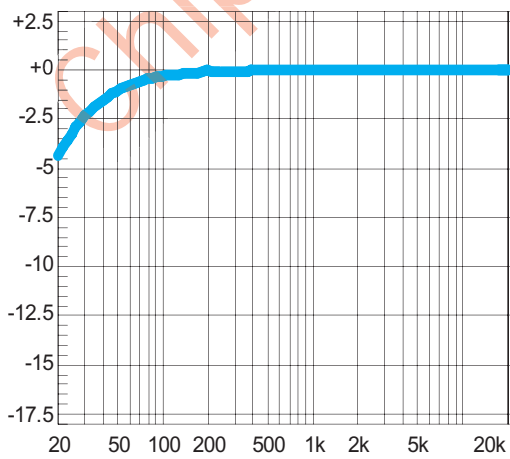


Figure 25. Frequency Response
SE mode, 5V, 320hm, C5/C6=220uF

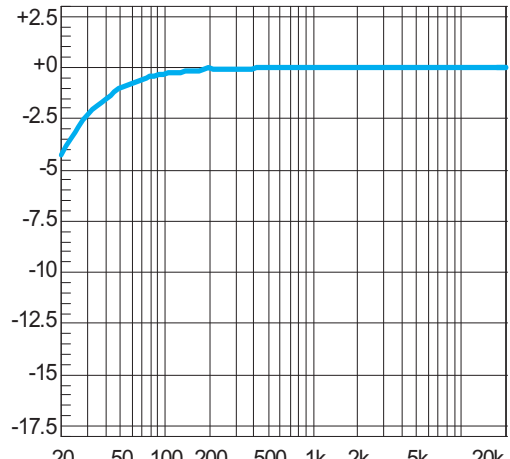


Figure 26. Frequency Response
SE mode, 3V, 320hm, C5/C6=220uF

典型特征曲线

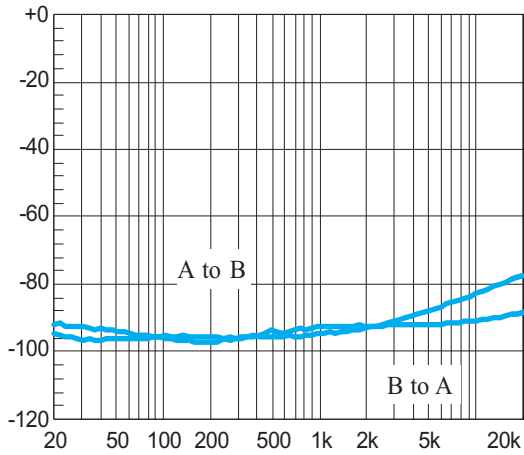


Figure 27. Crosstalk
BTL mode, 5V, 8Ohm, $P_o=1W$

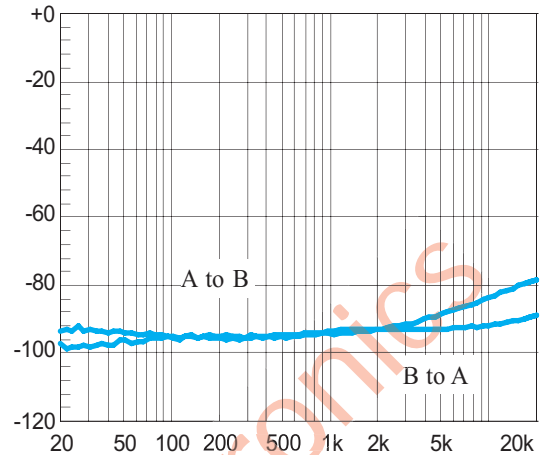


Figure 28. Crosstalk
BTL mode, 3V, 8Ohm, $P_o=0.3W$

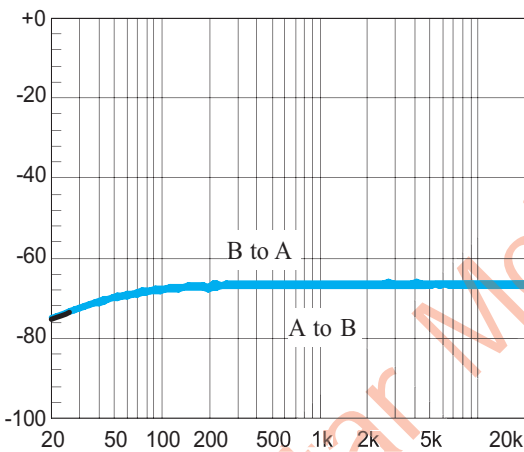


Figure 29. Crosstalk
SE mode, 5V, 32Ohm, $P_o=80mW$

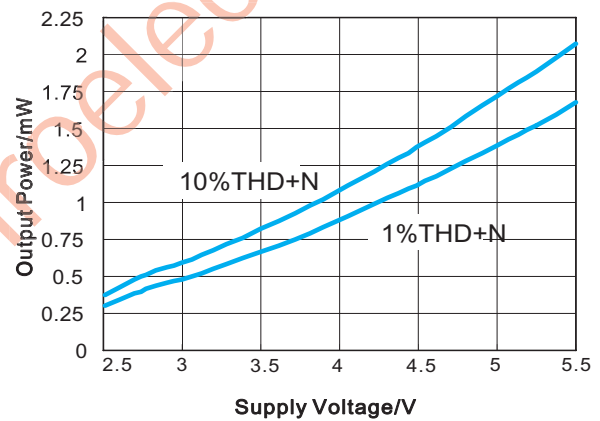


Figure 30. Output Power vs. Power Supply
BTL mode, $f=1\text{ kHz}$, $R_L=8\text{ Ohm}$

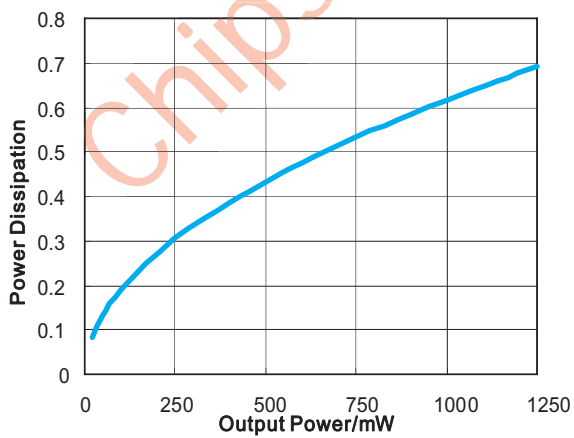


Figure 31. Power Dissipation vs. Output Power
BTL mode, 5V, $f=1\text{ kHz}$, $R_L=8\text{ Ohm}$, $\text{THD+N} \leq 1\%$

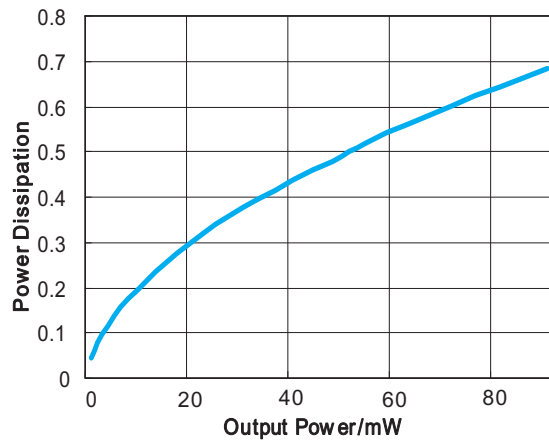


Figure 32. Power Dissipation vs. Output Power
SE mode, 5V, $f=1\text{ kHz}$, $R_L=32\text{ Ohm}$

应用信息

CS4863系列基本结构描述

CS4863系列是双端输出的立体声音频功率放大器，内部集成两级四个运算放大器(如典型应用电路图所示)，构成双通道(A,B通道)立体音频放大器。(以下为A通道的论述，同时也适合于B通道)放大器A1的增益是外部配置结构决定的，闭环增益通过配置 R_f 和 R_i 来决定；而放大器A2的增益有内部电阻结构决定，固定为-1，A2构成倒相放大器。驱动的负载连接到两个放大器输出端之间。放大器A1的输出作为放大器A2的输入，这样导致两个放大器产生幅值相同，相位差180°，利用相位不同，当负载连接于-OUTA和+OUTA输出端之间且为差动输出时(通常被称作“桥式模型”)，该IC各通道的差动增益为：

$$A_{Vo} = 2 \times \frac{R_f}{R_i} \quad (1)$$

桥式模型放大器的运行不同于单终端放大器结构，在单终端结构中负载的一端接放大器的输出而另一端接地。桥式放大器设计比单终端结构有一些明显的优点：当它给负载提供差动驱动时，负载两端的电压为单终端情况下的两倍。因此，在相同条件下，假定放大器没有电流限制或断路，可获得的输出功率中，这种增加导致输出功率可能是单终端放大器的4倍。当选定一个的放大器闭环增益时，为了不引起过分失真(过分失真将会损坏扬声器系统中的高频率传感器)，对电路的设计有一定的要求，请参考“音频功率放大器设计”部分。放大器桥式结构优于单终端的第二个优点是，由于A通道和B通道的差动输出均在半供给中偏置，通过负载不存在净直流电压，这就消除了单电源、单终端模式下存在的输出耦合电容。单电源、单终端放大器中，则需通过负载的半供给偏置来消除输出耦合电容，这样便会导致内部IC功耗的增加，以及扬声器永久性损坏。

电源旁路

对于任何功率放大器，适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制是非常关键的。典型运用中，使用一个5V的调节器，这个调节器具有一个10 μ F和一个0.1 μ F的旁路电容，有助于电源稳定，降低输入噪声和改善电源瞬态响应。在电源和地间连接电容的导线及内部连线应尽可能缩短。在管脚BYPASS与地间连接一个1 μ F的电容 C_B 可改善内部偏置电压的稳定性和提高放大器的抑制比PSRR，当 C_B 增大时PSRR也随之提高，但 C_B 增加太大则会影响放大器的降噪性能。

芯片功耗

要设计一个成功的放大器，无论这个放大器是桥式还是单终端式，功耗都应该重点考虑。等式(2)表明单终端放大器在给定电源电压、驱动一定的负载时耗散功率为：

$$P_{DMAX} = VDD^2 / (2 \times \pi^2 \times RL) \quad (2)$$

然而，桥式放大器中传递给负载的功率增大也导致内部功耗的增加。由于CS4863系列的一个通道中含有两个运算放大器，所以桥式工作模式的最大内部功耗是单终端模式的4倍。等式(3)表明桥式放大器在给定5V电源电压、驱动4 Ω 的负载时耗散功率单通道为1.27W或立体模式(双通道)为2.54W：

$$P_{DMAX} = 4 \times (VDD)^2 / (2 \times \pi^2 \times RL) \quad (3)$$

从等式(3)中计算得的最大功耗点一定不会比等(4)的功耗点大：

$$P_{DMAX} = (T_{JMAX} - T_A) / \theta_{JA} \quad (4)$$

由于CS4863系列的 $T_{JMAX} = 150^\circ\text{C}$ ，TSSOP封装焊接到PCB上5in2铜片连接的DAP衬垫的热阻 θ_{JA} 为20 $^\circ\text{C}/\text{W}$ ，而MTE封装中焊接到与PCB上2in2铜片连接的DAP衬垫的热阻 θ_{JA} 为41 $^\circ\text{C}/\text{W}$ 。依赖于系统周围的环境温度 T_{JA} ，所以等式(4)可用以决定由IC组件支持的最大内部功耗。重新整理等式(4)并代入 P_{DMAX} 得到等式(5)，该等式表明在CS4863系列的结温不变时，环境温度也随音频系统输出功率有所变化。

$$T_A = T_{JMAX} - 2 \times P_{DMAX} \theta_{JA} \quad (5)$$

对于5V电源4 Ω 负载的典型应用，在不超过最大结温及能输出最大音频功率情况下最大可能环境温度TSSOP封装为99 $^\circ\text{C}$ 而MTE封装为45 $^\circ\text{C}$ ：

$$T_{JMAX} = P_{DMAX} \theta_{JA} + T_A \quad (6)$$

等式(6)给出了最大结温 T_{JMAX} 。如这个结果影响到CS4863系列的 θ_{JA} 至150 $^\circ\text{C}$ ，通过减小工作电压或提高负载阻抗达到减小最大结温，再进一步可通过环境温度补偿来实现。以上所述均假定器件运行在最大功耗点附近。由于内部功耗是输出功率的函数，当输出功率减小时，环境温度可进一步提高。参考典型性能特征曲线，该曲线显示了低输出功率的功耗信息。如果等式(2)的结果大于等式(3)的结果，则要么是电源电压降低要么是负载阻抗增加或环境温度减小。如这些调节还不够，则需增加一散热铜片来减小 θ_{JA} 。散热片附加包在管芯外，与电源、地及放大器的输出端连接。与外部焊接到SMT散热片可用7106D热合金也会改善功耗。当增加有散热片时， θ_{JA} 便是 θ_{JC} 、 θ_{CS} 和 θ_{SA} 的总和(θ_{JC} 为结与外壳的热阻， θ_{CS} 为外壳与散热片的热阻， θ_{SA} 为散热片与环境的热阻)。

关断模式

为了节电，在不使用放大器时，可以关闭放大器，CS4863系列有关断控制管脚，可以控制放大器是否工作。该控制管脚的电平必须要接满足接口要求的控制信号，否则芯片可能进入不定状态，而不能进入关断模式，其自功耗没有降低，达不到节电目的。

有几种方法可以实现低功耗关断功能，包括用单极、单掷开关进行切换，用微控制器或微处理器输出来控制关断电路。如果开关的切换来实现，则需在管脚SHUTDOWN与电源连上一个10 KΩ的上拉电阻或管脚SHUTDOWN直接连到地。当管脚SHUTDOWN接地时放大器正常工作。当打开通过上拉电阻与电源连接的开关时，关断功能就启动。开关及上拉电阻确保管脚SHUTDOWN不会悬空，以免出现我们不希望的不定状态。一些系统中用微控制器或微处理器输出信号给管脚SHUTDOWN来控制关断功能，代替用上拉电阻的关断电路。

表1SHUTDOWN和HPSENSE操作的逻辑真值表

SHUTDOWN	HPSENSE	工作模式
低	逻辑低	桥式放大
低	逻辑高	单端放大
高	逻辑低/高	关断

HPSENSE功能

给HPsense加上一个4V~VDD的电压可关断运算放大模块A2和A4，使桥式连接的负载失效。当此IC处于单端工作模式时静态电流也会随之减小。

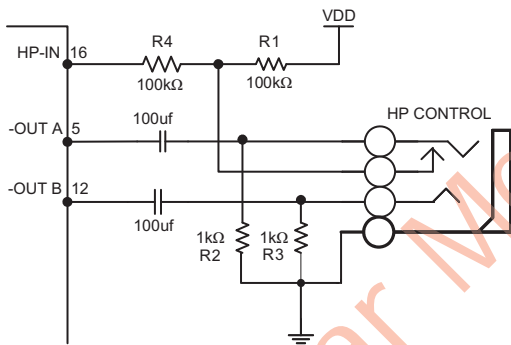


图34 立体耳机工作电路示意图

上图为耳机控制功能工作示意图，当没有耳机插头接入插孔时，R1-R2 分压电阻使提供到HPsense 管脚的电压近似为50mV，驱动A3和A4处于工作状态，使CS4863系列工作于桥式模式。输出耦合电容隔离半供给直流电压，起到保护耳机的作用。输入HPsense管脚的高电平为4V。当CS4863系列工作于桥式模式时，实质上负载两端的电压为0V。因此甚至为理想状态下，难以引发放大器处于单端输出的工作模式。耳机接入耳机插孔使得耳机插孔与-OUTA分离并使R1上接HPsense管脚的电压至VDD。这样耳机关断功能把A2和A4给关断且桥式连接的扬声器就不工作了，放大器便驱动输出耦合阻抗为R2和R3的耳机，当耳机阻抗为典型值32Ω时，输出耦合阻抗R2、R3对CS4863系列输出驱动能力的影响可忽略不计。图34也是耳机插孔的内部连接关系示意图，插孔为一组三线插头的设计，尖端和环分别为立体双声道的一个信号输出，然而最外端的环为地。当连接耳机时有一个控制端连接的耳机插孔足以驱动HPsense管脚。一个微处理器或开关可以代替耳机插孔中连接控制端的功能，微处理器或开关向HPsense提供4V~VDD的电压，这样连接扬声器的桥式模式便停止工作且A1和A2分别驱动耳机的左、右声道。

Bypass电容的选取

仔细考虑与BYPASS管脚相连的电容CB可使输入电容的尺寸减小到最小。因为CB决定CS4863系列静态工作点的稳定性，所以当开启有爆裂的输入信号时它的值非常关键。CS4863系列的输出倾斜到静态直流电压(VDD/2)越慢，则开启的pop声越小。选取1.0uF的CB且Ci为小电容(0.1uf到0.39uf的范围)，则可得到一个“滴答声”和“Pop声”都较小的关断功能。鉴于以上讨论，选取可满足带宽需要的、不太大的Ci有助于使“滴答声”和“Pop”减小到最小。

输入电容的选取

放大低频音频信号需要较大的输入电容(图1中的Ci)在便携式设计的配件中高值电容较昂贵且损害到器件的工作效率。然而在许多情况下，便携式系统中无论是内部还是外部，都有少许远低于150Hz的信号。用输入大电容可使放大扬声器的应用中低频响应极限获得一些改善。此外，Ci影响系统的成本和尺寸，对CS4863系列的滴答声和Pop声这一性能也有影响。当电压第一次加上时，产生一个瞬态的爆裂信号使电荷充电到电容，电容便从0跃变到一个静态状态。当大量的爆裂声输入时则需要输入电容尺寸较大，二者成比例关系。当电流一定时需要达到静态直流电压(通常为VDD/2)大电容则需要更长的时间。放大器的输出通过反馈电阻加载到输入电容。所以，通过适当选取不高于必要的-3dB频率的输入电容可以使爆裂声减小到最小。如图1所示，输入电阻Ri和输入电容Ci产生一个-3dB高通滤波器可由等式(7)得到。

$$f_{-3dB} = \frac{1}{2\pi R_i C_i} \quad (7)$$

优化降噪性能

CS4863系列包含有使开启或关断的瞬态值或“滴答声和Pop声”减小到最小的电路。讨论中开启指的是电源电压的加载或撤消关断模式。当电源电压逐渐升至最终值时，CS4863系列的内部放大器就好比配置成整体增益的缓冲器一样，内部电流源加载一个受线性方式约束的电压到BYPASS管脚。理论上输入和输出的电压高低将随加到BYPASS管脚的电压而改变。直到加载至BYPASS管脚的电压升到VDD/2，内部放大器的增益保持整体稳定。加载到BYPASS管脚上的电压一稳定，整个器件就处于完全工作状态。虽然不能改变BYPASS管脚的电流，但CB的改变可以改变器件的开启时间和大量的“滴答声和Pop声”。无论如何，从这种现象中得到一种权衡：CB增大，开启时间便随之增大，且二者成线性关系。以下是不同的CB值及其对应的开启时间：

CB	TON
0.01 uf	1ms
0.1 uf	14ms
0.22 uf	30ms
0.47 uf	63ms
1.0 uf	130ms

为了消除噪声，所有的电容须在开启前放电。迅速的关闭电闸不能使电容完全放电反而导致“滴答声和Pop声”。在单终端工作模式中，输出通过C_{OUT}连接到负载，通常这个电容较大，它通过20KΩ的内部电阻放电。C_{OUT}的放电时间持续长短依赖于它的尺寸大小，为了减小单端模式下瞬态响应的影响，在外部配置一个与内部20KΩ电阻并联的1KΩ或者5KΩ的电阻，但这个电阻会增大静态电流。

音频功率放大器的设计

给定的指标要求

- 输出功率 1 Wrms
- 负载阻抗 8Ω
- 输入电平 1 Wrms
- 输入阻抗 20KΩ
- 带宽 100Hz ~ 20KHz ± 0.25dB

设计者必须首先确定所需的电源范围，以获得规定的输出功率。一种方法是从“典型性能特性”部分中的“输出功率-电源电压”曲线图，可以很容易推出电源范围。确定所需电源范围的第二种方式是给定负载阻抗时用等式(4)计算所需的V_{OPEAK}。为了估算放大器的内部消耗电压，基于特征性能“消耗电压-电源电压”曲线图，根据等式(8)得到的结果必须外加两个电源电压以补偿。这样，工作电压如等式(9)的所示结果。

$$V_{OPEAK} = 2R_L P_o \quad (8)$$

$$V_{DD} \geq (V_{OPEAK} + (V_{ODTOP} + V_{ODBOG})) \quad (9)$$

从“输出功率-电源电压”曲线图中可见负载为8Ω时最小工作电源电压为4.6V，通常电源电压为5V即这个条件很容易满足。额外的电源电压产生动态空间，允许CS4863系列产生一个峰值超过1W而没有断碎的可听失真信号。同时设计者必须选定电源电压的和输出阻抗不能超过在“功耗”部分所阐述的条件。一旦功耗因素满足条件后，所要求的差动增益就可由等式(10)确定。

$$A_{VD} \geq \frac{\sqrt{P_o \times R_L}}{V_{IN}} = V_{orms} / V_{inrms} \quad (10)$$

由等式(10)得最小的A_{VD}=2.83，这使CS4863系列具备低噪声、低THD+N且输出较理想性能，在此应用实例中取A_{VD}=3。放大器的增益由输入电阻R_i及反馈电阻R_f的配置决定，当输入阻抗为20kΩ时，由等式(11)可得到反馈电阻的阻值。

$$\frac{R_f}{R_i} = \frac{A_{VD}}{2} \quad (11)$$

由于要求输入阻抗为20 kΩ，且A_{VD}=3，R_f/R_i=1/1.5，由此可得R_f的值是30 kΩ。最后的设计是确定-3dB 频率带宽规格。要达到放大±0.25dB的大量音频信号，则要求低频响应至少扩充了最低带宽频率限制点的1/5或最高带宽频率限制点的5倍，当带宽限制为0.17dB时，能满足这两个要求，这比所要求的±0.25dB要好。这就使得低频和高频极点分别为20Hz和100KHz。R_i和C_i连接形成一个高通滤波器以截止低频率信号。可从等式(12)得出所连接电容的值。

$$C_i \geq \frac{1}{2\pi R_i f_c} \quad (12)$$

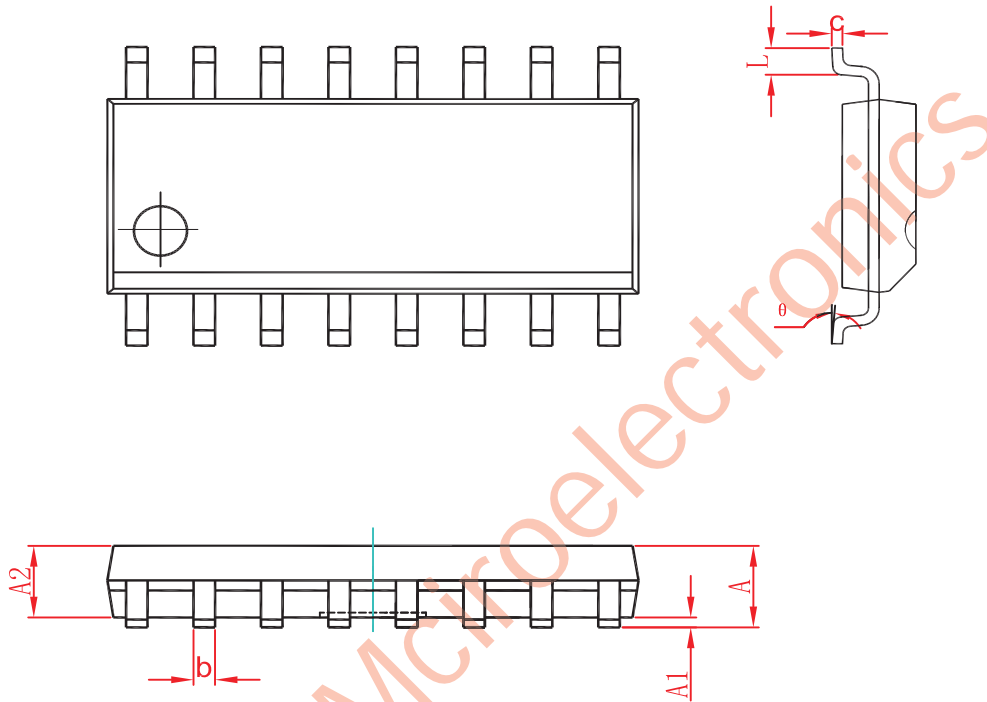
结果为:

$$\frac{1}{2\pi \times 20\text{KHz} \times 20\text{Hz}} = 0.398\mu\text{F} \quad (13)$$

该电容取最接近标准值的0.39μF。产品的高频极值f_H(在此例中为100kHz)和差动增益A_{VD}决定高频响应的频率点。由A_{VD}=3，f_H=100kHz可得闭环增益带宽(GBWP)是300kHz,这个容限范围表明，该放大器也适用于要求更多差动增益且具备消除带宽限制的特征。

封装信息

CS4863S SOP16L



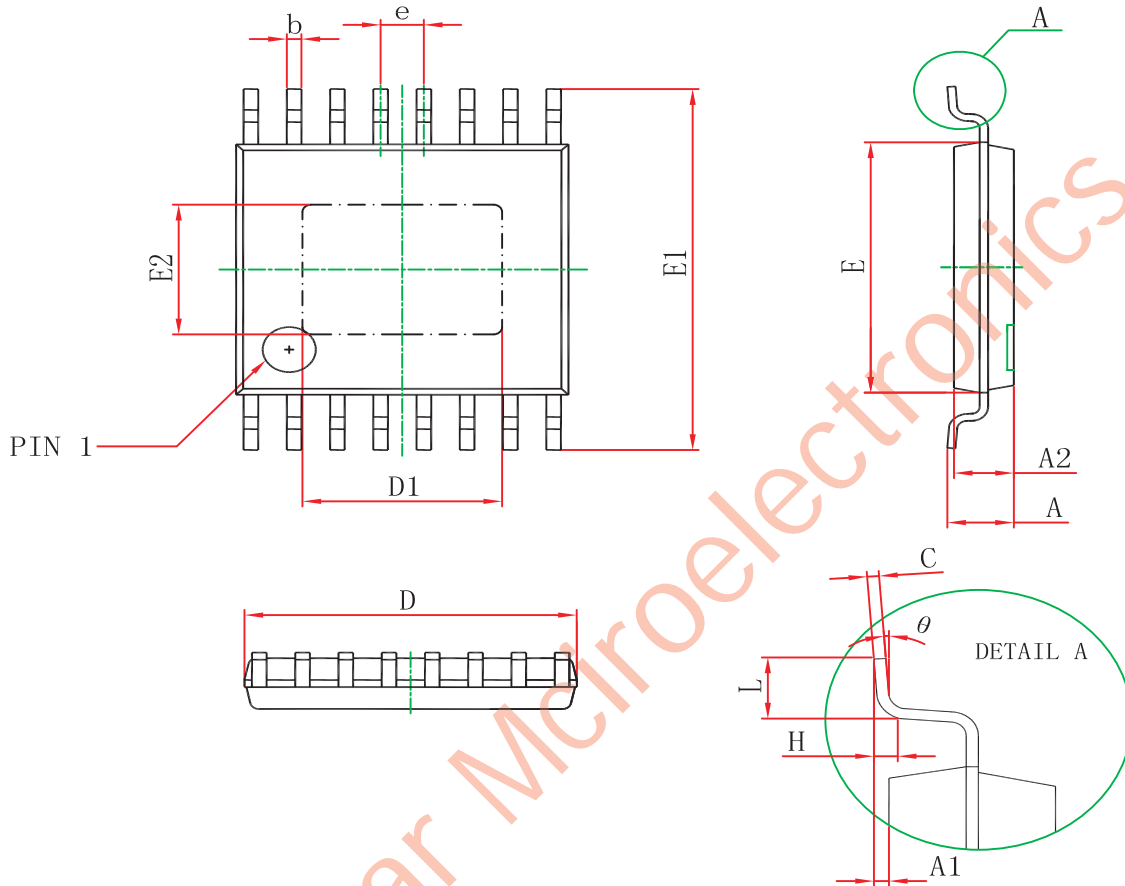
Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	9.800	10.200	0.386	0.402
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	$^{\circ}0$	$^{\circ}8$	$^{\circ}0$	$^{\circ}8$

Notes:

- (1) 所有尺寸都为毫米
- (2) 参考JEDEC MO-229标准

封装信息

CS4863R TSSOP16-PP



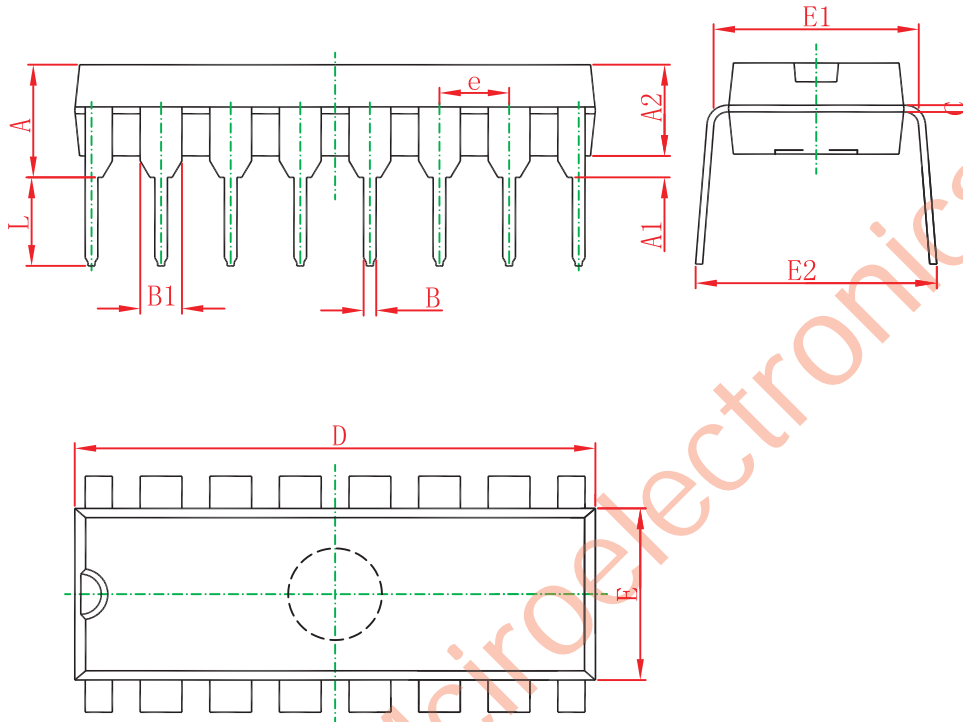
Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
D	4.900	5.100	0.193	0.201
D1	2.900	3.100	0.114	0.122
E	4.300	4.500	0.169	0.177
b	0.190	0.300	0.007	0.012
c	0.090	0.200	0.004	0.008
E1	6.250	6.550	0.246	0.258
E2	2.200	2.400	0.087	0.094
A		1.100		0.043
A2	0.800	1.000	0.031	0.039
A1	0.020	0.150	0.001	0.006
e	0.65 (BSC)		0.026(BSC)	
L	0.500	0.700	0.02	0.028
H	0.25(TYP)		0.01(TYP)	

Notes:

(1) 所有尺寸都为毫米

封装信息

CS4863N DIP16L



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.710	4.310	0.146	0.170
A1	0.510		0.020	
A2	3.200	3.600	0.126	0.142
B	0.380	0.570	0.015	0.022
B1	1.524(BSC)		0.060(BSC)	
C	0.204	0.360	0.008	0.014
D	18.800	19.200	0.740	0.756
E	6.200	6.600	0.244	0.260
E1	7.320	7.920	0.288	0.312
e	2.540(BSC)		0.100(BSC)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142
E2	8.400	9.000	0.331	0.354

Notes:

- (1) 所有尺寸都为毫米
- (2) 参考JEDEC MO-229标准



MOS电路操作注意事项：

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止MOS电路由于受静电放电影响而引起的损坏：

- 操作人员要通过防静电腕带接地。
- 设备外壳必须接地。
- 装配过程中使用的工具必须接地。
- 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。

声明：

- 上海智浦欣微电子有限公司保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在使用前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用上海智浦欣产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- 产品品质的提升永无止境，上海智浦欣微电子有限公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！